

概要

同时搭载可视光和PL (Photoluminescence) 双通路光源, 可应对SiC/GaN前道工序中所需要的所有外观缺陷检测, 以及外延层结晶缺陷的检测。

特别是**针对Pattern后晶圆内部新增结晶缺陷的检测功能, 填补了传统工艺对此工序无法监控的空白。**为良品率提高保驾护航。

用途

SiC/GaN前道工序中所需要的所有外观缺陷检测, 外延层结晶缺陷的检测, **Pattern后晶圆内部新增结晶缺陷的检测。**

规格

支持的晶圆尺寸:2~8inch

检测分辨率:0.325um ~

检测速度:15min (4inch晶圆 5x PL检测时)

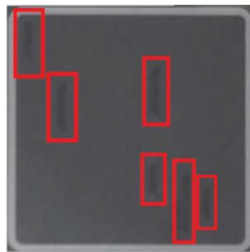
检测缺陷种类:基底面位错 (BPD)、积层缺陷 (SF) 等结晶缺陷, 模样外观 (pattern) 不良等



<SiC 可视光检测>



<SiC PL检测>



<SiC PL检测>

